

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60747-5-1

1997

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1
2001-03

Amendement 1

**Dispositifs discrets à semiconducteurs
et circuits intégrés –**

**Partie 5-1:
Dispositifs optoélectroniques – Généralités**

Amendment 1

**Discrete semiconductor devices
and integrated circuits –**

**Part 5-1:
Optoelectronic devices – General**

© IEC 2001 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland
IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

D

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 47E: Dispositifs discrets à semi-conducteurs, du comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
47E/178/FDIS	47E/184/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne sera pas modifié avant 2004. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

Page 10

4.13 Photocoupleur, optocoupleur

Ajouter les nouveaux paragraphes suivants:

4.13.1 photocoupleur/optocoupleur à entrée continue

photocoupleur/optocoupleur dont l'élément d'entrée est un émetteur optoélectronique auquel du courant continu est appliqué

4.13.2 photocoupleur/optocoupleur à entrée alternative

photocoupleur/optocoupleur dont l'élément d'entrée est un émetteur monté tête-bêche auquel du courant alternatif est appliqué

4.13.3 photocoupleur/optocoupleur à phototransistor

photocoupleur/optocoupleur dont l'élément photosensible est un phototransistor

NOTE Une borne de base peut ou non exister.

4.13.4 photocoupleur/optocoupleur à photodarlington

photocoupleur/optocoupleur dont l'élément photosensible est un phototransistor Darlington

NOTE Une borne de base peut ou non exister.

4.13.5 photocoupleur/optocoupleur à photothyristor

photocoupleur/optocoupleur dont l'élément photosensible est un photothyristor

NOTE Les régions de gâchette peuvent ou non ressortir comme des broches électriques.

FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 47E: Discrete semiconductor devices, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
47E/178/FDIS	47E/184/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendments will remain unchanged until 2004. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

Page 11

4.13 Photocoupler, optocoupler

Add the following new subclauses:

4.13.1 DC input photocoupler/optocoupler

photocoupler/optocoupler consisting at the input of an optoelectronic emitter to which d.c. current is applied

4.13.2 AC input photocoupler/optocoupler

photocoupler/optocoupler consisting at the input of an antiparallel optoelectronic emitter to which a.c. current is applied

4.13.3 phototransistor photocoupler/optocoupler

photocoupler/optocoupler whose photosensitive element is a phototransistor

NOTE A base terminal may or may not be provided.

4.13.4 photodarlington photocoupler/optocoupler

photocoupler/optocoupler whose photosensitive element is a Darlington phototransistor

NOTE A base terminal may or may not be provided.

4.13.5 photothyristor photocoupler/optocoupler

photocoupler/optocoupler whose photosensitive element is a photothyristor

NOTE A gate terminal may or may not be provided.

4.13.6 photocoupleur/optocoupleur à phototriac

photocoupleur/optocoupleur dont l'élément photosensible est un phototriac

4.13.7 photocoupleur/optocoupleur à sortie à CI

photocoupleur/optocoupleur dont l'élément photosensible se compose d'une photodiode/phototransistor et d'un circuit intégré

4.13.8 photocoupleur/optocoupleur à TEC

photocoupleur/optocoupleur dans lequel l'élément de sortie se compose d'un ou de plusieurs transistors à effet de champ

NOTE Un TEC est activé par photo-élément ou par rayonnement optique direct.

4.13.9 photocoupleur/optocoupleur à photodiode

photocoupleur/optocoupleur dont l'élément photosensible est une photodiode

4.13.10 photocoupleur/optocoupleur à entrée à CI

photocoupleur/optocoupleur dont les éléments d'entrée se composent d'un circuit intégré et d'un émetteur optoélectronique

Page 20

6 Termes relatifs aux valeurs limites et aux caractéristiques

Remplacer, aux pages 30 et 32, le titre des paragraphes 6.2.6.2 et 6.2.7.2 par le nouveau titre suivant:

Largeur de spectre $\Delta\lambda$

Remplacer, à la page 34, le titre du paragraphe 6.2.7.3 par le nouveau titre suivant:

Largeur de ligne $\Delta\lambda_L$

Remplacer, à la page 36, en 6.2.7.6, le terme «largeur de spectre de rayonnement» par:

Largeur de spectre

Page 46

6.4 Photocoupleurs, optocoupleurs

Ajouter, à la page 54, les nouveaux paragraphes suivants:

4.13.6 phototriac photocoupler/optocoupler

photocoupler/optocoupler whose photosensitive element is a phototriac

4.13.7 IC photocoupler/optocoupler

photocoupler/optocoupler whose photosensitive element is a photodiode/phototransistor and an integrated circuit

4.13.8 FET photocoupler/optocoupler

photocoupler/optocoupler with one or more field-effect transistors (FETs) in its output stage

NOTE A FET is activated by photo-elements or by direct optical radiation.

4.13.9 photodiode photocoupler/optocoupler

photocoupler/optocoupler whose photosensitive element is a photodiode

4.13.10 IC input photocoupler/optocoupler

photocoupler/optocoupler whose input elements consist of an integrated circuit and an opto-electronic emitter

Page 21

6 Terms related to ratings and characteristics

Replace on pages 31 and 33, the title of subclauses 6.2.6.2 and 6.2.7.2 by the following new title:

Spectrum bandwidth $\Delta\lambda$

Replace, on page 35, the title of subclause 6.2.7.3, by the following new title:

Line width $\Delta\lambda_L$

Replace, on page 37, in 6.2.7.6, the term "spectral radiation bandwidth" by:

Spectrum bandwidth

Page 47

6.4 Photocouplers, optocouplers

Add, on page 55, the following new subclauses:

6.4.17 Tension de pointe répétitive

6.4.17.1 tension de pointe répétitive à l'état bloqué

tension directe de pointe répétitive maximale applicable entre l'anode et la cathode à l'état bloqué dans des conditions de gâchette spécifiées

NOTE La tension répétitive a une vitesse maximale d'accroissement inférieure à la vitesse critique de croissance de la tension à l'état bloqué (dv/dt).

6.4.17.2 tension de pointe répétitive en inverse

tension inverse de pointe répétitive maximale applicable entre l'anode et la cathode dans des conditions de gâchette spécifiées

6.4.17.3 courant à l'état passant en valeur efficace

valeur quadratique moyenne maximale applicable du courant direct entre l'anode et la cathode à l'état passant dans des conditions spécifiées de gâchette

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60747-5-1:1997/AMD1:2001